



2SD1073: Transistor Darlington High Power NPN 50V 4A



Descripción

Nombre: TRANSISTOR DARLINGTON HIGH POWER **Referencia:** 2SD1073

- Polaridad del transistor: NPN
- Configuración: Single
- Corriente CC máxima de colector: 4A
- Máx. voltaje VCEO colector-emisor: 250V
- Tensión VCBO colector-base: 300V
- Voltaje VEBO emisor-base: 30V
- Voltaje de saturación colector-emisor: 1.5V (IC=1A;IB=10mA)
- Dp - Disipación de potencia: 60 mW
- Temperatura de trabajo: desde - 55°C hasta + 150°C

Marca: FUJI[FUJI ELECTRIC] **Empaque:** TO-220 **Precio por:** Unidad **Ficha técnica:** [2SD1073](#)

Información del producto

Descripción: TRANSISTOR DARLINGTON HIGH POWER. Marca: FUJI[FUJI ELECTRIC]. Referencia: 2SD1073 El 2SD1073 es un transistor Darlington NPN de alta potencia, ideal para aplicaciones que requieren una alta ganancia de corriente y la capacidad de manejar cargas significativas. Su versatilidad y robustez lo convierten en un componente muy utilizado en electrónica de potencia.

Precio: \$9.332 IVA INCLUIDO

SKU: 9-5-136

Categorías: [SEMICONDUCTORES](#), [TRANSISTORES Y REGULADORES](#)

Etiquetas: [0090005000136](#), [2SD1073](#), [9-5-136](#), [datasheet](#), [FUJI\[FUJI ELECTRIC\]](#), [pinout](#), [SEMICONDUCTORES](#), [Through Hole](#), [TRANSISTOR DARLINGTON HIGH POWER](#), [TRANSISTORES Y REGULADORES](#)

Exchange Information		Product Specification		
Silicon NPN Power Transistors		2SD1073		
DESCRIPTION				
• High V _{CEO} collector-base voltage				
• High DC current gain				
• Darlington structure				
• Low saturation voltage				
APPLICATIONS				
• Audio power amplifiers				
• Relay and solenoid drivers				
• Motor drives				
• General purpose power amplifiers				
PACKAGE				
Case	TO-220			
Pin 1	Base			
Pin 2	Collector			
Pin 3	Emitter			
Absolute maximum ratings (Ta=25°C)				
Symbol	Parameter	Conditions	Value	Unit
V _{CEO}	Collector-emitter voltage	Open emitter	250	V
V _{CE0}	Collector-base voltage	Open emitter	300	V
V _{BE0}	Emitter-base voltage	Open collector	30	V
I _C	Collector current	Open emitter	4	A
I _E	Emitter current		4.4	A
V _{CE(sat)}	Collector-emitter saturation voltage	I _C =1A, I _B =100mA	1.5	V
V _{BE(sat)}	Emitter-base saturation voltage	I _C =1A, I _B =100mA	1.0	V
V _{CE}	Collector-emitter voltage	I _C =1A, I _B =100mA	100-150	V
THERMAL CHARACTERISTICS				
Symbol	Characteristic	Value	Unit	
R _{θ(j-c)}	Thermal resistance junction to case	0.4	°C/W	